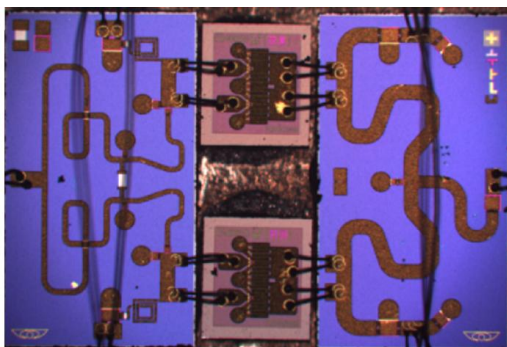




Процесс РМІС

Технология изготовления пассивных СВЧ МИС на подложках GaAs



Технология изготовления пассивных СВЧ МИС на подложках GaAs (процесс РМІС) подходит для разработки СВЧ фильтров, аттенуаторов, делителей мощности, схем согласования, коррекции и суммирования для квазимонолитных интегральных схем.

Технология позволяет формировать тонкопленочные резисторы, МДМ-конденсаторы, спиральные катушки индуктивности и сквозные металлизированные отверстия.

Технология доступна в режиме foundry.

Параметры процесса РМІС

Элемент	Параметр	Ед. изм.	Значение
Металлизация 1	Толщина	мкм	0,05/0,3 (Ti/Au)
Металлизация 2	Толщина	мкм	2,5 (Au)
Металлизация 3	Толщина	мкм	до 7 (Au)
МДМ-конденсаторы	Удельная емкость	пФ/мм ²	750
	Пробивное напряжение	В	70
WSi-резисторы	Слоевое сопротивление	Ом/кв	20, 50
Подложка	Толщина	мкм	100

С использованием процесса РМІС были разработаны МИС МР501, МР503, МР504.

По вопросам заказа и уточнения параметров обращаться по e-mail: mmic@niipp.ru или по тел. (3822) 28-82-48.

С номенклатурой МИС СВЧ можно ознакомиться по ссылке <http://www.niipp.ru/catalog/> в разделе «Монолитные интегральные схемы СВЧ».